



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0081421
(43) 공개일자 2014년07월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09K 11/06 (2006.01) H01L 51/50 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0151150
(22) 출원일자 2012년12월21일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
롬엔드하스전자재료코리아유한회사
충청남도 천안시 서북구 3공단1로 56 (백석동)
(72) 발명자
안희춘
경기 수원시 영통구 영통로174번길 62, 105호 (매포동, 신흥빌라)
양수진
경기 화성시 동탄숲속로 95, 811동 1101호 (능동, 숲속마을광명메이루즈아파트)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
장훈

전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) 발명의 명칭 **신규한 유기 전계 발광 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자**

(57) 요약

본 발명은 신규한 유기 전계 발광 화합물 및 이를 포함하고 있는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물은 전류 효율 및 발광 효율이 향상된 OLED 소자를 제조할 수 있는 장점이 있다.

(72) 발명자

문두현

경기 화성시 병점중앙로 204, 104동 101호 (진안동, 월드메르디앙1단지아파트)

전지송

경기 화성시 효행로1039번길 8-13, 403호 (진안동, 발렌티노빌)

이태진

서울 동대문구 한천로11길 10, 109동 903호 (답십리동, 동아아파트)

이경주

서울 마포구 새창로8길 72, 210동 1001호 (도화동, 도화현대홈타운아파트)

권혁주

서울 강남구 학동로68길 29, 105동 2003호 (삼성동, 삼성동힐스테이트1단지아파트)

김봉욱

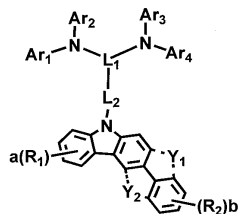
서울 강남구 삼성로111길 8, 208동 401호 (삼성동, 삼성동힐스테이트2단지아파트)

특허청구의 범위

청구항 1

하기 화학식 1로 표시되는 유기 전계 발광 화합물.

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

L_1 은 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이고;

L_2 은 단일결합, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이며;

Ar_1 내지 Ar_4 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환(C1-C30)알킬기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기이고;

Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})- 이며, Y_1 과 Y_2 는 둘 중 하나만 존재하고;

R_{31} 내지 R_{33} 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 또는 치환 또는 비치환된 (5-30원)헤테로아릴이며; R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-30원)단일환 또는 다환의 치환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있고, 상기 형성된 치환족 또는 방향족 환의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있으며;

R_1 및 R_2 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환 (C3-C30)시클로알킬기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알콕시기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬실릴기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴실릴기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아르(C1-C30)알킬실릴기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬아미노기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴아미노기, 또는 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴아미노기이거나; 서로 인접한 치환체와 연결되어 (3-30 원)단일환 또는 다환의 치환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있고, 상기 형성된 치환족 또는 방향족 환의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있으며;

상기 헤테로아릴(렌)은 B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로부터 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함하고;

a 및 b는 각각 독립적으로 1 내지 4의 정수이고, a 또는 b가 2이상인 경우 각각의 R_1 및 R_2 는 동일하거나 상이할 수 있다.

청구항 2

제1항에 있어서, L_1 , L_2 , Ar_1 내지 Ar_4 , R_{31} 내지 R_{33} , R_1 , 및 R_2 에서 치환 알킬, 치환 아릴(렌), 치환 헤테로아릴(렌), 치환 알콕시, 치환 시클로알킬, 치환 알킬실릴, 치환 아릴실릴, 치환 아르알킬실릴, 치환 알킬아미노, 치환 아릴아미노, 또는 치환 알킬아릴아미노의 치환체는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노, 카르복실, 니트로, 히드록시, (C1-C30)알킬, 할로(C1-C30)알킬, (C2-C30)알케닐, (C2-C30)알키닐, (C1-C30)알콕시, (C1-C30)알킬티오, (C3-C30)시클로알킬, (C3-C30)시클로알케닐, (3-7원) 헤테로시클로알킬, (C6-C30)아릴옥시, (C6-C30)아릴티오, (C6-C30)아릴로 치환되거나 비치환된 (5-30원) 헤테로아릴, (5-30원) 헤테로아릴로 치환되거나 비치환된 (C6-C30)아릴, 트리(C1-C30)알킬실릴, 트리(C6-C30)아릴실릴, 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, (C1-C30)알킬디(C6-C30)아릴실릴, 아미노, 모노 또는 디(C1-C30)알킬아미노, 모노 또는 디(C6-C30)아릴아미노, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴아미노, (C6-C30)아릴(5-30원) 헤테로아릴아미노, (C1-C30)알킬카보닐, (C1-C30)알콕

시카보닐, (C6-C30)아릴카보닐, 디(C6-C30)아릴보로닐, 디(C1-C30)알킬보로닐, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴보로닐, (C6-C30)아르(C1-C30)알킬 및 (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것인, 유기 전계 발광 화합물.

청구항 3

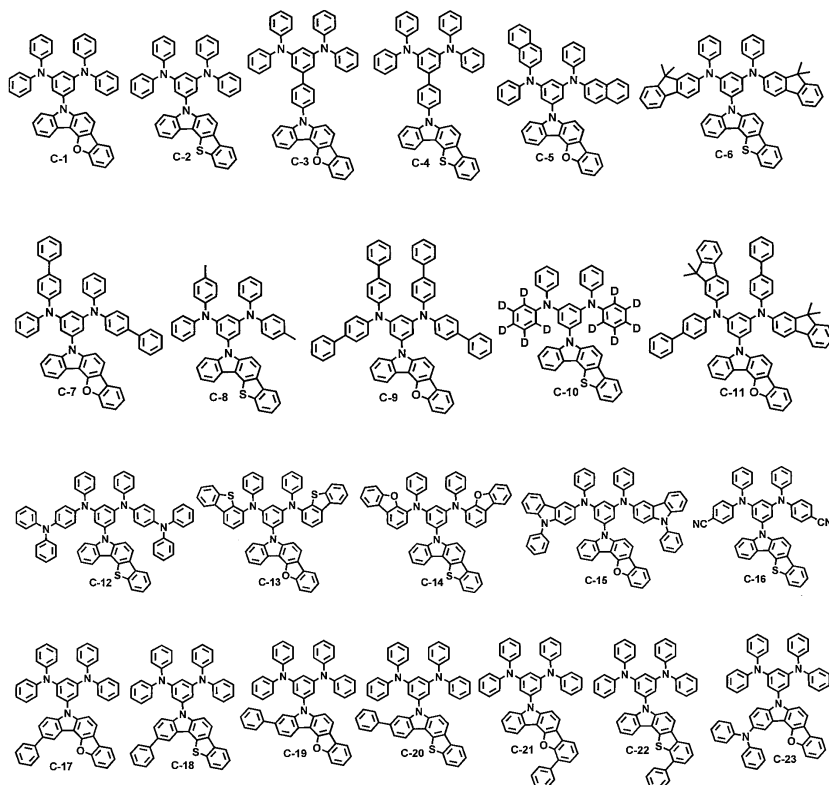
제1항에 있어서, L_1 은 비치환 (C6-C30)아릴렌기이고; L_2 는 단일결합, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이며; Ar_1 내지 Ar_4 는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기이고; Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})-이며; R_{31} 내지 R_{33} 이 각각 독립적으로 비치환 (C1-C30)알킬, 또는 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴이거나; R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-30원)단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하고; R_1 및 R_2 는 각각 독립적으로 수소, 비치환 (C6-C30)아릴기, 비치환 (5-30 원)헤테로아릴기, 또는 비치환 (C6-C30) 아릴아미노기이며; a 및 b는 각각 독립적으로 1 내지 2의 정수인, 유기 전계 발광 화합물.

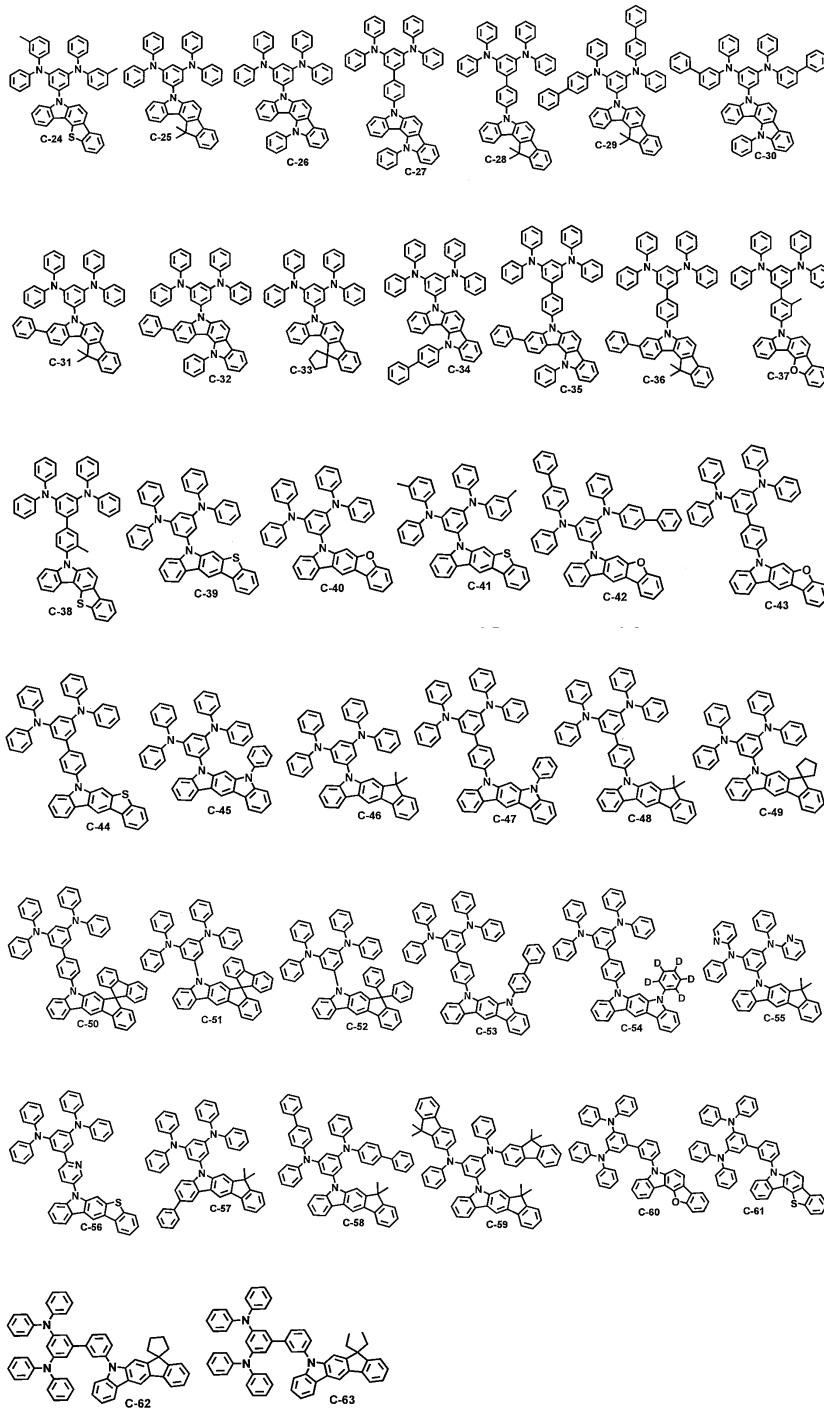
청구항 4

제1항에 있어서, L_1 은 비치환 (C6-C20)아릴렌기이고; L_2 는 단일결합, (C1-C6)알킬기로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴렌기, 또는 비치환(5-20원) 헤테로아릴렌기이며; Ar_1 내지 Ar_4 는 각각 독립적으로 중수소, 시아노, (C1-C6)알킬기, 또는 (C6-C20)아릴아미노기로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴기; 또는 (C6-C20)아릴기로 치환 또는 비치환된 (5-20원) 헤테로아릴기이고; Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})-이며; R_{31} 내지 R_{33} 이 각각 독립적으로 비치환 (C1-C6)알킬, 또는 중수소로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴이고; R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-20원)단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하고; R_1 및 R_2 는 각각 독립적으로 수소, 비치환 (C6-C20)아릴기, 비치환 (5-20 원)헤테로아릴기 또는 비치환 (C6-C20)아릴아미노기이며; a 및 b는 각각 독립적으로 1 내지 2의 정수인, 유기 전계 발광 화합물.

청구항 5

제1항에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화합물로부터 선택되는, 유기 전계 발광 화합물.





청구항 6

제1항의 유기 전계 발광 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 소자.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 신규한 유기 전계 발광 화합물 및 이를 포함하고 있는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 표시 소자 중, 유기 전계 발광 소자(OLED)는 자체 발광형 표시 소자로서 시야각이 넓고 명암비(contrast)가 우

수할 뿐만 아니라 응답속도가 빠른 장점이 있다. 1987년 이스트만 코닥(Eastman Kodak)사는 발광층 형성용 재료로서 저분자인 방향족 디아민과 알루미늄 착물을 이용하고 있는 유기 EL 소자를 처음으로 개발하였다[Appl. Phys. Lett. 51, 913, 1987].

[0003] 유기 전계 발광 소자에서 발광 효율을 결정하는 가장 중요한 요인은 발광 재료이다. 발광 재료로는 현재까지 형광 발광 재료가 널리 사용되고 있으나, 전계 발광의 메커니즘상 형광 발광 재료에 비해 인광 발광 재료가 이론적으로 4배까지 발광 효율을 개선시킬 수 있다는 점에서 인광 발광 재료의 개발 연구가 널리 수행되고 있다. 현재까지 이리듐(III)착물 계열이 인광 발광 재료로 널리 알려져 있으며, 각 RGB 별로는 (acac)Ir(btp)₂ (비스(2-(2'-벤조티에닐)-피리디네이트-N,C-3'))이리듐(아세틸아세토네이트)), Ir(ppy)₃ (트리스(2-페닐피리딘)이리듐) 및 Firpic (비스(4,6-디플루오로페닐피리디네이트-N,C2)피콜리네이트이리듐) 등의 재료가 알려져 있다.

[0004] 발광 재료는 색순도, 발광효율 및 안정성을 향상시키기 위해 호스트 재료에 발광 재료(도펀트)를 혼합하여 사용하기도 한다. 이와 같은 발광 재료(도펀트)/호스트재료 체계를 사용할 때, 호스트 재료는 발광 소자의 효율과 성능에 큰 영향을 미치므로, 그 선택이 중요하다.

[0005] 종래 기술에서, 인광용 호스트 재료로는 4,4'-N,N'-디카르바졸-비페닐(CBP)가 가장 널리 알려져 있었다. 최근에는, 일본의 파이오니어 등이 정공차단층의 재료로 사용되던 바토크프로인(Bathocuproine, BCP) 및 알루미늄(III)비스(2-메틸-8-퀴놀리네이트)(4-페닐페놀레이트)(Balq) 등을 호스트 재료로 이용해 고성능의 유기 전계 발광 소자를 개발한 바 있다.

[0006] 그러나 기존의 이러한 인광용 호스트 재료들은 발광 특성 측면에서는 유리한 면이 있으나, 다음과 같은 단점이 있다: (1) 유리 전이 온도가 낮고 열적 안정성이 낮아서, 진공 하에서 고온 증착 공정을 거칠 때, 물질이 변한다. (2) 유기 전계 발광 소자에서 전력효율 = $[(\pi/\text{전압}) \times \text{전류효율}]$ 의 관계에 있으므로 전력 효율은 전압에 반비례하는데, 인광용 호스트 재료를 사용한 유기 전계 발광 소자는 형광 재료를 사용한 유기 전계 발광 소자에 비해 전류 효율(cd/A)은 높으나, 구동 전압 역시 상당히 높기 때문에 전력 효율(lm/w) 면에서 큰 이점이 없다. (3) 또한, 유기 전계 발광 소자에 사용할 경우, 작동 수명 측면에서도 만족스럽지 못하며, 발광 효율도 여전히 개선이 요구된다.

[0007] 한편, 유기 전계 발광 소자에서 정공 주입 및 수송 재료로서 구리 프탈로시아닌(CuPc), 4,4'-비스[N-(1-나프틸)-N-페닐아미노]비페닐(NPB), N,N'-디페닐-N,N'-비스(3-메틸페닐)-(1,1'-비페닐)-4,4'-디아민(TPD), 4,4',4''-트리스(3-메틸페닐페닐아미노)트리페닐아민(MTDATA) 등이 사용되어 왔으나, 이러한 물질을 사용한 경우 유기 전계 발광 소자는 양자 효율 및 수명이 저하되는 문제가 있었다. 그 이유는 유기 전계 발광 소자를 높은 전류에서 구동하게 되면, 양극과 정공 주입층 사이에서 열 스트레스(thermal stress)가 발생하고, 이러한 열 스트레스에 의해 소자의 수명이 급격히 저하되기 때문이다. 또한, 정공 주입층에 사용되는 유기물질은 정공의 운동성이 매우 크기 때문에, 정공과 전자의 전하 밸런스(hole-electron charge balance)가 깨지고 이로 인해 양자 효율(cd/A)이 낮아지게 된다.

[0008] 한국공개특허공보 KR 2011-0129766 A 는 카바졸에 헤테로원자를 포함하는 오원환 및 벤젠고리가 융합된 골격에서 카바졸의 탄소원자에 아릴아민기 또는 아릴아민기로 치환된 아릴기가 결합된 화합물을 유기 전계 발광 소자용 유기 염료로 개시하고 있다.

[0009] 한국공개특허공보 KR 2010-0131271 A 는 인데노카바졸 골격에서 카바졸의 탄소원자에 아릴아민기 또는 아릴옥시기 등이 결합되거나 아릴아민기 또는 아릴옥시기 등으로 치환된 아릴기가 결합된 화합물을 유기 전계 발광 소자용 화합물로 개시하고 있다.

[0010] 한국공개특허공보 KR 2011-0049665 A 는 카바졸, 다이벤조카바졸, 또는 아크리딘이 융합된 카바졸 골격에서 카바졸의 탄소원자에 2개의 디아릴아미노기로 치환된 아릴기가 결합된 화합물을 유기 전계 발광 소자용 화합물로 개시하고 있다.

[0011] 한국공개특허공보 KR 2011-0061792 A 는 디벤조카바졸 골격의 질소원자에 1개 또는 2개의 디아릴아미노기로 치환된 아릴기가 결합된 화합물을 유기 전계 발광 소자용 화합물로 개시하고 있다.

[0012] 그러나, 상기 문헌들은 벤젠환 및 오원환과 융합된 카바졸 골격의 질소원자에서 2개의 디아릴아민기로 치환된 아릴기 등이 결합된 구조를 갖는 화합물 및 이를 정공전달층으로 사용한 유기 전계 발광 소자에 대하여는 구체적으로 개시하고 있지 않다.

- [0013] [선행기술문헌]
 [0014] [특허문헌]
 [0015] (특허문헌 1) 한국공개특허 KR 2011-0129766 A (2011.12.02 공개)
 [0016] (특허문헌 2) 한국공개특허 KR 2010-0131271 A (2010.12.15 공개)
 [0017] (특허문헌 3) 한국공개특허 KR 2011-0049665 A (2011.05.12 공개)
 [0018] (특허문헌 4) 한국공개특허 KR 2011-0061792 A (2011.06.10 공개)

발명의 내용

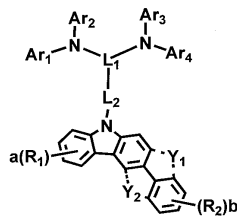
해결하려는 과제

- [0019] 본 발명의 목적은 발광층 및 정공전달층 중 하나 이상에 포함되면서 기존의 재료보다 전류 효율 및 발광 효율이 좋은 유기 전계 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0020] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위해 예의 연구한 결과, 본 발명자들은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물이 상술한 목적을 달성함을 발견하여 본 발명을 완성하였다.

- [0021] [화학식 1]



- [0022]
 [0023] 상기 화학식 1에서,
 [0024] L_1 은 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이고;
 [0025] L_2 은 단일결합, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이며;
 [0026] Ar_1 내지 Ar_4 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환(C1-C30)알킬기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기이고;
 [0027] Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})- 이며, Y_1 과 Y_2 는 둘 중 하나만 존재하고;
 [0028] R_{31} 내지 R_{33} 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 (5-30원)헤테로아릴이며; R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-30원)단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있고, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 환의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있으며;
 [0029] R_1 및 R_2 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환 (C3-C30)시클로알킬기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알콕시기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬실릴기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴실릴기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아르(C1-C30)알킬실릴기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬아미노기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴아미노기, 또는 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴아미노기이거나; 서로 인접한 치환체와 연결되어 (3-30 원)단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있고, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 환의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있으며;
 [0030] 상기 헤테로아릴(렌)은 B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로부터 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함하고;

[0031] a 또는 b는 각각 독립적으로 1 내지 4의 정수이고, a 또는 b가 2이상인 경우 각각의 R_1 , R_2 는 동일하거나 상이할 수 있다.

발명의 효과

[0032] 본 발명에 따른 화합물은 전류 효율 및 발광 효율이 우수하여 소자의 발광 특성이 뛰어난 유기 전계 발광 소자를 제조할 수 있는 장점이 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0033] 이하에서 본 발명을 더욱 상세히 설명하나, 이는 설명을 위한 것으로 본 발명의 범위를 제한하는 방법으로 해석되어서는 안 된다.

[0034] 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 유기 전계 발광 화합물, 상기 유기 전계 발광 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 재료 및 상기 재료를 포함하는 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

[0035] 본 발명의 상기 화학식 1로 표시되는 유기 전계 발광 화합물에 대해 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

[0036] 상기 화학식 1에서, 바람직하게는,

[0037] L_1 은 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이고, 바람직하게는 비치환 (C6-C30)아릴렌기이며, 더욱 바람직하게는 비치환 (C6-C12)아릴렌기이다.

[0038] L_2 는 단일결합, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이고, 바람직하게는 단일결합, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이며, 더욱 바람직하게는 단일결합, (C1-C6)알킬기로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴렌기, 또는 비치환(5-20원) 헤테로아릴렌기이다.

[0039] Ar_1 내지 Ar_4 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환(C1-C30)알킬기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기이고, 바람직하게는 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기이며, 더욱 바람직하게는 중수소, 시아노, (C1-C6)알킬기, 또는 (C6-C20)아릴아미노기로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴기, 또는 (C6-C20)아릴기로 치환 또는 비치환된 (5-20원) 헤테로아릴기이다.

[0040] Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})- 이며, Y_1 과 Y_2 는 둘 중 하나만 존재하고, R_{31} 내지 R_{33} 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원)헤테로아릴이며, R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-30원)단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있고, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 환의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있으며, 바람직하게는 -O-, -S-, -C(R_{32})(R_{33})-이며, Y_1 과 Y_2 는 둘 중 하나만 존재하고, R_{31} 내지 R_{33} 이 비치환 (C1-C30)알킬, 또는 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴이거나, R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-30원)단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하는 것이고, 더욱 바람직하게는 -O-, -S-, -C(R_{32})(R_{33})-이며, Y_1 과 Y_2 는 둘 중 하나만 존재하고, R_{31} 내지 R_{33} 이 비치환 (C1-C6)알킬, 또는 중수소로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴이거나, R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-20원)단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하는 것이다.

[0041] R_1 및 R_2 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 시아노기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환 (C3-C30)시클로알킬기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알콕시기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬실릴기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴실릴기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아르(C1-C30)알킬실릴기, 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬아미노기, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴아미노기, 또는 치환 또는 비치환 (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴아미노기이거나; 서로 인접한 치환체와 연결되어 (3-30원)단일환 또는 다환의 지환족 또는 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족 또는 방향족 환의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 대체될 수 있고, 바람직하게는 수소, 중수소, 비치환 (C6-C30)아릴기, 비치환 (5-30원)헤테로아릴기, 또는 비치환 (C6-C30) 아릴아미노기이며, 더욱 바람직하게는 수소, 비치환 (C6-C20)아릴기 또는 비치환 (C6-C20)아릴아미노기이

다.

[0042] a 또는 b는 각각 독립적으로 1 내지 4의 정수이고, 바람직하게는 1 내지 2의 정수이며, a 또는 b가 2이상인 경우 각각의 R_1 및 R_2 는 동일하거나 상이할 수 있다.

[0043] 본원 발명의 일실시예에 따르면, 상기 화학식 1에서, L_1 은 비치환 (C6-C30)아릴렌기이고; L_2 는 단일결합, 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴렌기, 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴렌기이며; Ar_1 내지 Ar_4 는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴기, 또는 치환 또는 비치환 (5-30원) 헤테로아릴기이고; Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})- 이며, R_{31} 내지 R_{33} 이 각각 독립적으로 비치환 (C1-C30)알킬, 또는 치환 또는 비치환 (C6-C30)아릴이거나, R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-30원)단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하고; R_1 및 R_2 는 각각 독립적으로 수소, 비치환 (C6-C30)아릴기, 비치환 (5-30 원)헤테로아릴기, 비치환 (C6-C30) 아릴아미노기이며; a 또는 b는 각각 독립적으로 1 내지 2의 정수이고, a 또는 b가 2이상인 경우 각각의 R_1 , R_2 는 동일하거나 상이할 수 있다.

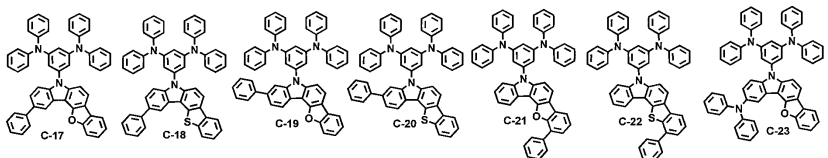
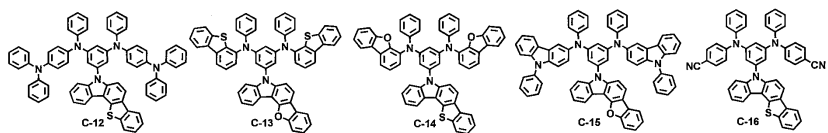
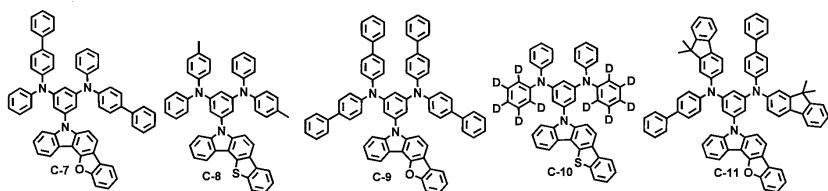
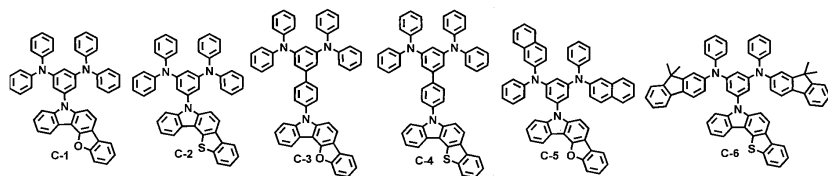
[0044] 본원 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 화학식 1에서, L_1 은 비치환 (C6-C20)아릴렌기이고; L_2 는 단일결합, (C1-C6)알킬기로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴렌기, 또는 비치환 (5-20원) 헤테로아릴렌기이며; Ar_1 내지 Ar_4 는 각각 독립적으로 중수소, 시아노, (C1-C6)알킬기, 또는 (C6-C20)아릴아미노기로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴기, 또는 (C6-C20)아릴기로 치환 또는 비치환된 (5-20원) 헤테로아릴기이고; Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})- 이며, R_{31} 내지 R_{33} 이 각각 독립적으로 비치환 (C1-C6)알킬, 또는 중수소로 치환 또는 비치환된 (C6-C20)아릴이거나, R_{32} 및 R_{33} 은 서로 연결되어 (3-20원)단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하고; R_1 및 R_2 는 각각 독립적으로 수소, 비치환 (C6-C20)아릴기, 비치환 (5-20 원)헤테로아릴기 또는 비치환 (C6-C20)아릴아미노기이며; a 또는 b는 각각 독립적으로 1 내지 2의 정수이고, a 또는 b가 2 이상인 경우 각각의 R_1 , R_2 는 동일하거나 상이할 수 있다.

[0045] 본 발명에 기재되어 있는 “치환 또는 비치환” 이라는 기재에서 ‘치환’은 어떤 작용기에서 수소 원자가 다른 원자 또는 다른 작용기 (즉, 치환체)로 대체되는 것을 뜻한다. 상기 화학식 1 의 L_1 , L_2 , Ar_1 내지 Ar_4 , R_{31} 내지 R_{33} , R_1 및 R_2 , 및 하기 화학식 2 내지 6의 R_{21} 내지 R_{27} , L_4 , M 및 R_{31} 내지 R_{33} 에서 치환 알킬, 치환 아릴 (렌), 치환 헤테로아릴 (렌), 치환 알콕시, 치환 시클로알킬, 치환 알킬실릴, 치환 아릴실릴, 치환 아르알킬실릴, 치환 알킬아미노, 치환 아릴아미노, 또는 치환 알킬아릴아미노의 치환체는 각각 독립적으로 중수소, 할로젠, 시아노, 카르복실, 니트로, 히드록시, (C1-C30)알킬, 할로(C1-C30)알킬, (C2-C30)알케닐, (C2-C30)알키닐, (C1-C30)알콕시, (C1-C30)알킬티오, (C3-C30)시클로알킬, (C3-C30)시클로알케닐, (3-7 원) 헤테로 시클로알킬, (C6-C30)아릴옥시, (C6-C30)아릴티오, (C6-C30)아릴로 치환되거나 비치환된 (5-30원) 헤테로아릴, (5-30원) 헤테로아릴로 치환되거나 비치환된 (C6-C30)아릴, 트리(C1-C30)알킬실릴, 트리(C6-C30)아릴실릴, 디 (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, (C1-C30)알킬디(C6-C30)아릴실릴, 아미노, 모노 또는 디(C1-C30)알킬아미노, 모노 또는 디(C6-C30)아릴아미노, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴아미노, (C6-C30)아릴(5-30원) 헤테로아릴아미노, (C1-C30)알킬카보닐, (C1-C30)알콕시카보닐, (C6-C30)아릴카보닐, 디(C6-C30)아릴보로닐, 디(C1-C30)알킬보로닐, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴보로닐, (C6-C30)아르(C1-C30)알킬 및 (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴로 이루어진 군 으로부터 선택되는 하나 이상인 것을 의미하고, 각각 독립적으로 중수소, (C1-C6)알킬, (C6-C12)아릴, 디(C6-C12)아릴 아미노 및 시아노로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것이 바람직하다.

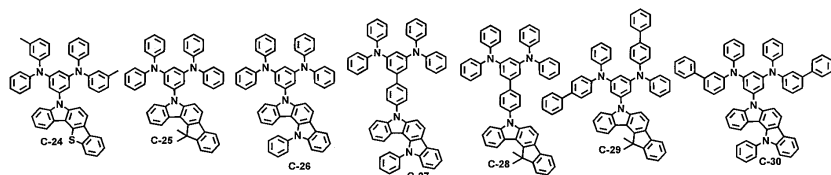
[0046] 본 발명에 기재되어 있는 “(C1-C30)알킬”은 탄소수가 1 내지 30개인 직쇄 또는 분지쇄 알킬(렌)을 의미하고, 여기에서 탄소수가 1 내지 10개인 것이 바람직하고, 1 내지 6개인 것이 더 바람직하다. 상기 알킬의 구체적인 예로서, 메틸, 에틸, n-프로필, 이소프로필, n-부틸, 이소부틸 및 tert-부틸 등이 있다. 본원에서 “(C2-C30)알 케닐”은 탄소수가 2 내지 30개인 직쇄 또는 분지쇄 알케닐을 의미하고, 여기에서 탄소수가 2 내지 20개인 것이 바람직하고, 2 내지 10개인 것이 더 바람직하다. 상기 알케닐의 구체적인 예로서, 비닐, 1-프로페닐, 2-프로페닐, 1-부테닐, 2-부테닐, 3-부테닐, 2-메틸부트-2-에닐 등이 있다. 본원에서 “(C2-C30)알키닐”은 탄소수가 2 내지 30개인 직쇄 또는 분지쇄 알키닐을 의미하고, 여기에서 탄소수가 2 내지 20개 인 것이 바람직하고, 2 내지 10개인 것이 더 바람직하다. 상기 알키닐의 예로서, 에티닐, 1-프로피닐, 2-프로피닐, 1-부티닐, 2-부티닐, 3-부티닐, 1-메틸펜트-2-이닐 등이 있다. 본원에서 “(C3-C30)시클로알킬”은 탄소수가 3 내지 30개인 단일환 또는

는 다환 탄화수소를 의미하고, 여기에서 탄소수가 3 내지 20개인 것이 바람직하고, 3 내지 7개인 것이 더 바람직하다. 상기 시클로알킬의 예로서, 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실 등이 있다. 본원에서 “(3-7원) 헤테로시클로알킬”은 환 골격 원자수가 3 내지 7개이고, B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 헤테로원자, 바람직하게는 O, S 및 N에서 선택되는 하나 이상의 헤테로원자를 포함하는 시클로알킬을 의미하고, 예를 들어, 테트라히드로푸란, 피롤리딘, 티올란, 테트라히드로피란 등이 있다. 본원에서 “(C6-C30)아릴(렌)”은 탄소수가 6 내지 30개인 방향족 탄화수소에서 유래된 단일환 또는 융합환계 라디칼을 의미하고, 여기에서 환 골격 탄소수가 6 내지 20개인 것이 바람직하고, 6 내지 15개인 것이 더 바람직하다. 상기 아릴의 예로서, 페닐, 비페닐, 터페닐, 나프틸, 비나프틸, 페닐나프틸, 나프틸페닐, 플루오레닐, 페닐플루오레닐, 벤조플루오레닐, 디벤조플루오레닐, 페난트레닐, 페닐페난트레닐, 안트라세닐, 인데닐, 트리페닐레닐, 피레닐, 테트라세닐, 페틸레닐, 크라이세닐, 나프타세닐, 플루오란테닐 등이 있다. 본원에서 “(5-30원) 헤테로아릴(렌)”은 환 골격 원자수가 5 내지 30개이고, B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함하는 아릴기를 의미한다. 헤테로원자수는 바람직하게는 1 내지 4개이고, 단일 환계이거나 하나 이상의 벤젠환과 축합된 융합환계일 수 있으며, 부분적으로 포화될 수도 있다. 또한, 본원에서 상기 헤테로아릴(렌)은 하나 이상의 헤테로아릴 또는 아릴기가 단일 결합에 의해 헤테로아릴기와 연결된 형태도 포함한다. 상기 헤테로아릴의 예로서, 푸릴, 티오펜일, 피롤릴, 이미다졸릴, 피라졸릴, 티아졸릴, 티아디아졸릴, 이소티아졸릴, 이속사졸릴, 옥사졸릴, 옥사디아졸릴, 트리아진일, 테트라진일, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 푸라진일, 피리딜, 피라진일, 피리미딘일, 피리다진일 등의 단일 환계 헤테로아릴, 벤조푸란일, 벤조티오펜일, 이소벤조푸란일, 디벤조푸란일, 디벤조티오펜일, 벤조이미다졸릴, 벤조티아졸릴, 벤조이소티아졸릴, 벤조이속사졸릴, 벤조옥사졸릴, 이소인돌릴, 인돌릴, 인다졸릴, 벤조티아디아졸릴, 퀴놀릴, 이소퀴놀릴, 신놀리닐, 퀴나졸리닐, 퀴녹살리닐, 카바졸릴, 페녹사진일, 페난트리딘일, 벤조디옥솔릴 등의 융합 환계 헤테로아릴 등이 있다. 본원에서 “할로겐”은 F, Cl, Br 및 I 원자를 포함한다.

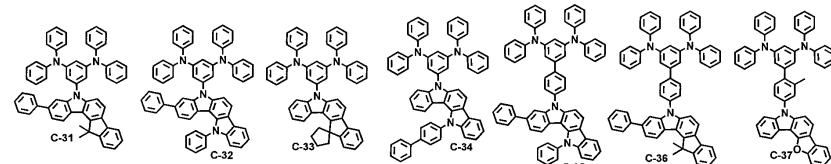
[0047] 상기 화학식 1의 유기 전계 발광 화합물은 보다 구체적으로 하기의 화합물로서 예시될 수 있으나, 이들에 한정되는 것은 아니다.



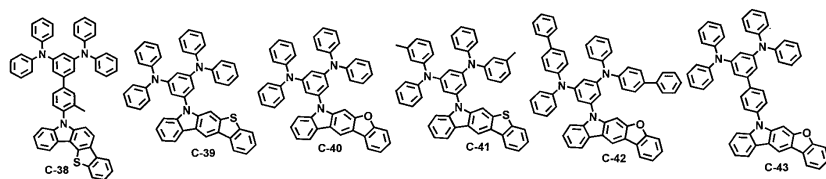
[0051]



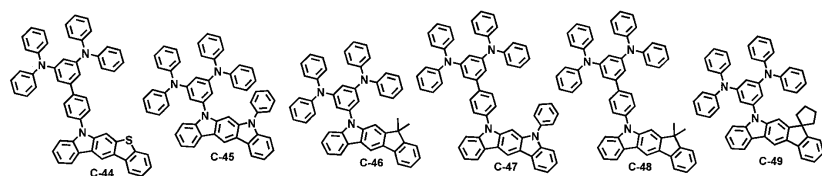
[0052]



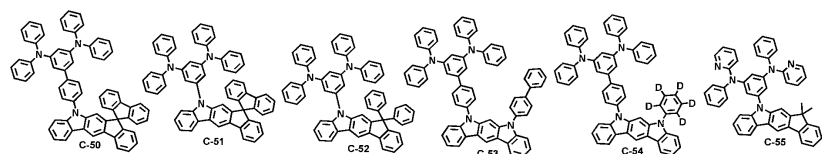
[0053]



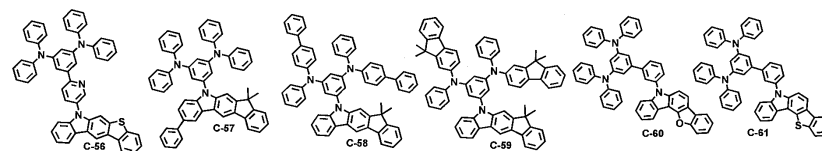
[0054]



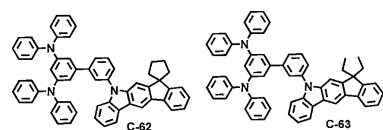
[0055]



[0056]



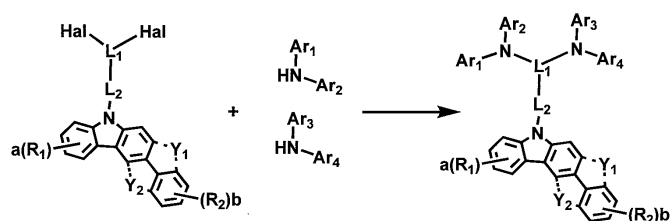
[0057]



[0058]

[0059] 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물은 당업자에게 공지된 합성 방법으로 제조할 수 있으며, 예를 들면 하기 반응식 1에 나타난 바와 같이 제조할 수 있다.

[0060] [반응식 1]



[0061]

[0062] 상기 반응식 1에서, L1, L2, Ar1 내지 Ar4, R1, R2, Y1, Y2, a 및 b는 화학식 1에서의 정의와 동일하고, Hal는

할로젠이다.

[0063] 또한, 본 발명은 화학식 1 의 유기 전계 발광 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 재료 및 상기 재료를 포함하는 유기 전계 발광 소자를 제공한다.

[0064] 상기 재료는 본 발명의 유기 전계 발광 화합물 단독으로 이루어질 수 있고, 유기 전계 발광 재료에 포함되는 통상의 물질들을 추가로 포함할 수도 있다.

[0065] 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자는 제1전극; 제2전극; 및 상기 제1전극 및 제2전극 사이에 개재되는 1층 이상의 유기물층을 갖고, 상기 유기물층은 상기 화학식 1의 화합물을 하나 이상 포함할 수 있다.

[0066] 상기 제1전극과 제2전극 중 하나는 애노드이고 다른 하나는 캐소드일 수 있다. 상기 유기물층은 발광층을 포함하고, 정공주입층, 정공전달층, 전자전달층, 전자주입층, 계면층(interlayer), 정공차단층 및 전자차단층에서 선택되는 1층 이상을 더 포함할 수 있다.

[0067] 본 발명의 유기 전계 발광 화합물은 상기 발광층 및 정공전달층 중 하나 이상에 포함될 수 있다. 정공전달층에 사용될 경우, 본 발명의 유기 전계 발광 화합물은 정공수송 재료로서 포함될 수 있다. 발광층에 사용될 경우, 본 발명의 유기 전계 발광 화합물은 호스트 재료로서 포함될 수 있다. 바람직하게는 상기 발광층은 하나 이상의 도펀트를 추가로 더 포함할 수 있다.

[0068] 본 발명의 유기 전계 발광 화합물이 발광층의 호스트 재료(제 1 호스트 재료)로서 포함되는 경우, 그 이외의 다른 화합물을 제 2 호스트 재료로 포함할 수 있다. 이때 제1 호스트 재료와 제 2호스트 재료의 중량비는 1:99 내지 99:1 범위일 수 있다.

[0069] 상기 제2호스트 재료는 공지된 인광 호스트라면 어느 것이든 사용 가능하나, 하기 화학식 2 내지 화학식 6으로 표시되는 화합물로 구성된 군으로부터 선택되는 것이 발광 효율 면에서 특히 바람직하다.

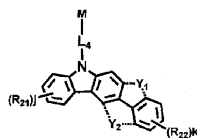
[0070] [화학식 2]

[0071] $H-(Cz-L_4)_h-M$

[0072] [화학식 3]

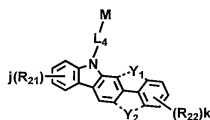
[0073] $H-(Cz)_i-L_4-M$

[0074] [화학식 4]



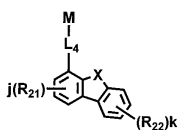
[0075]

[0076] [화학식 5]



[0077]

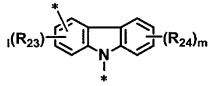
[0078] [화학식 6]



[0079]

[0080] 상기 화학식 2 내지 6에서,

[0081] Cz는 하기 구조이며,



[0082]

[0083] X는 -O- 또는 -S-이고;

[0084] R_{21} 내지 R_{24} 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로겐, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 (5-30원) 헤테로아릴 또는 $R_{25}R_{26}R_{27}Si-$ 이며;

[0085] R_{25} 내지 R_{27} 는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 또는 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴이고;

[0086] L_4 은 단일결합, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌, 또는 치환 또는 비치환된 (5-30원) 헤테로아릴렌이며;

[0087] M은 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 또는 치환 또는 비치환된 (5-30원) 헤테로아릴이고;

[0088] Y_1 및 Y_2 는 각각 독립적으로 -O-, -S-, -N(R_{31})-, 또는 -C(R_{32})(R_{33})-이며, Y_1 과 Y_2 가 동시에 존재하지는 않고;

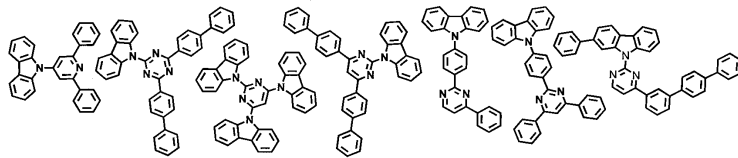
[0089] R_{31} 내지 R_{33} 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 (5-30원)헤테로아릴이며, R_{32} 및 R_{33} 은 동일하거나 상이할 수 있고;

[0090] h 및 i는 각각 독립적으로 1 내지 3의 정수이고;

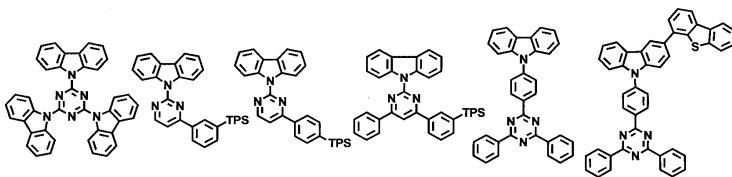
[0091] j, k, l 및 m은 각각 독립적으로 0 내지 4의 정수이며;

[0092] h, i, j, k, l 또는 m이 2 이상의 정수인 경우 각각의 (Cz- L_4), 각각의 (Cz), 각각의 R_{21} , 각각의 R_{22} , 각각의 R_{23} 또는 각각의 R_{24} 는 동일하거나 상이할 수 있다.

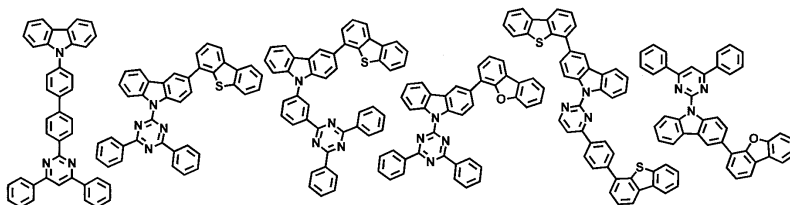
[0093] 구체적으로 상기 제2호스트 재료의 바람직한 예는 다음과 같다.



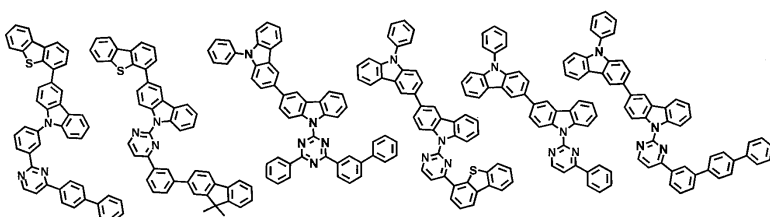
[0094]



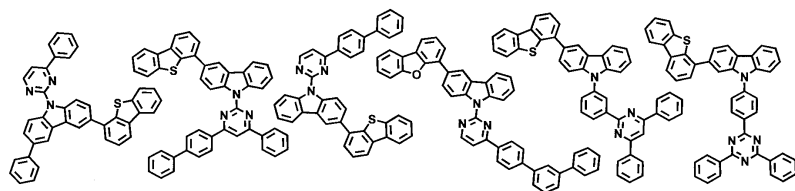
[0095]



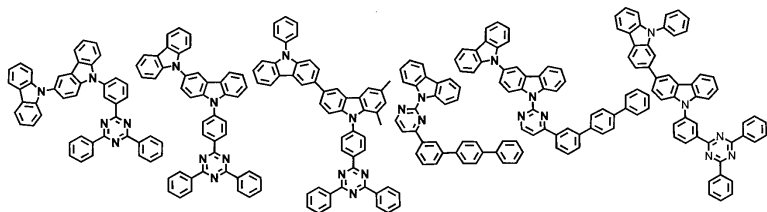
[0096]



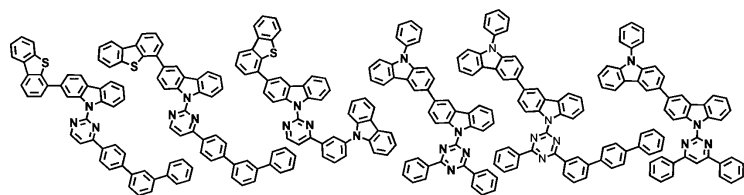
[0097]



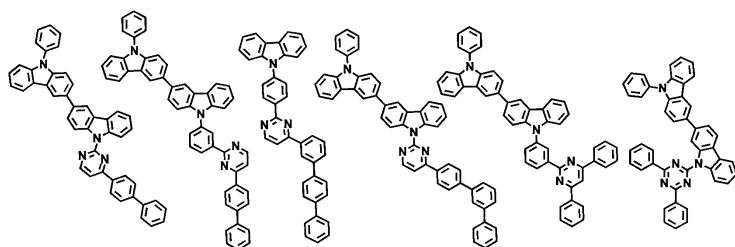
[0098]



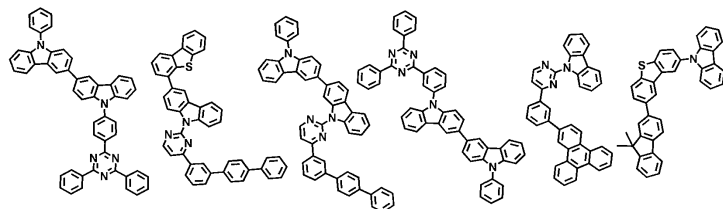
[0099]



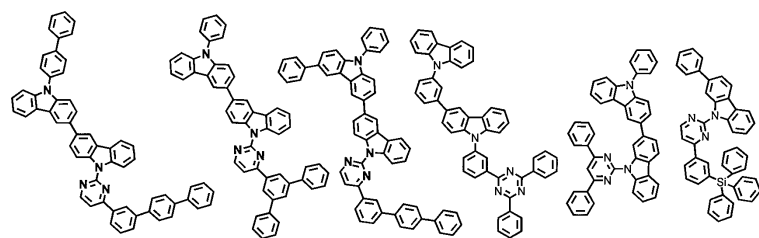
[0100]



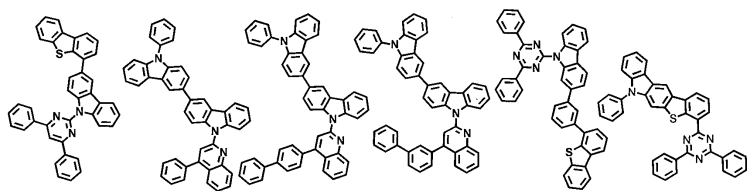
[0101]



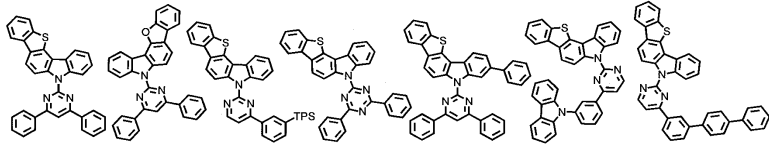
[0102]



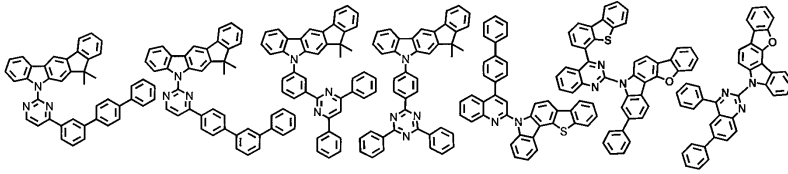
[0103]



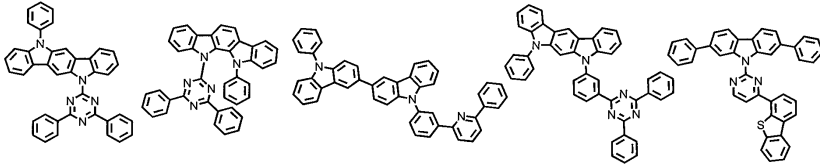
[0104]



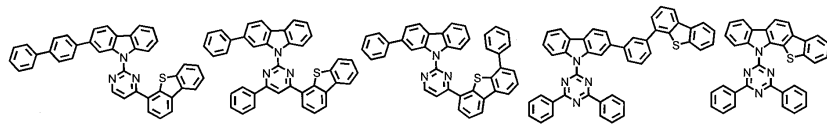
[0105]



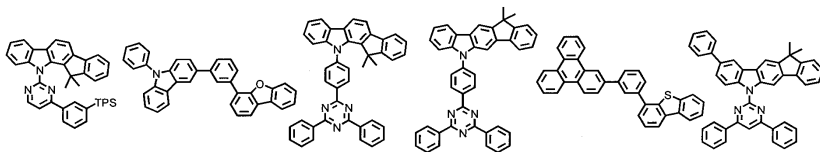
[0106]



[0107]



[0108]

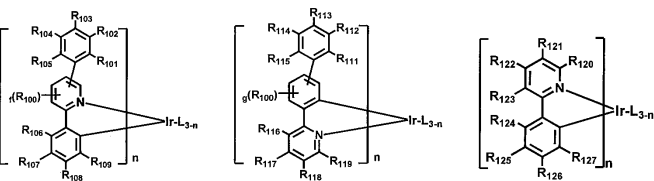


[0109]

[0110] 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 포함되는 도펀트로는 하나 이상의 인광 도펀트가 바람직하다. 이러한 인광 도펀트 재료는 특별히 제한되지는 않으나, 이리듐(Ir), 오스뮴(Os), 구리(Cu) 및 백금(Pt)으로부터 선택되는 금속 원자의 착체 화합물이 바람직하고, 이리듐(Ir), 오스뮴(Os), 구리(Cu) 및 백금(Pt)으로부터 선택되는 금속 원자의 오르토 메탈화 착체 화합물이 더욱 바람직하며, 오르토 메탈화 이리듐 착체 화합물이 더더욱 바람직하다.

[0111] 상기 인광 도펀트는 하기 화학식 7 내지 화학식 8로 표시되는 화합물로 구성된 군으로부터 선택되는 것이 바람직하다.

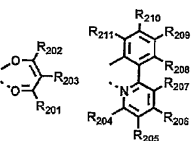
[0112] [화학식 7] [화학식 8] [화학식 9]



[0113]

[0114] 상기 화학식 7내지 9에서,

[0115] L은 하기 구조에서 선택되고;



[0116]

[0117] R₁₀₀은 수소, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 또는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬이며;

[0118] R_{101} 내지 R_{109} 및 R_{111} 내지 R_{123} 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 할로젠으로 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 시아노, 또는 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알콕시이고; R_{120} 내지 R_{123} 은 인접 치환기가 서로 연결되어 융합고리를 형성할 수 있는데, 예를 들어 퀴놀린 형성이 가능하며;

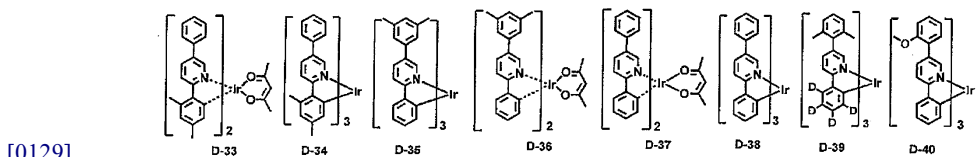
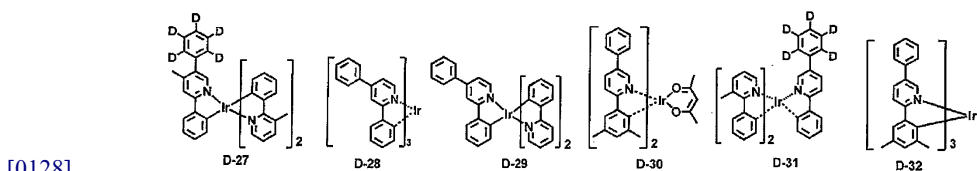
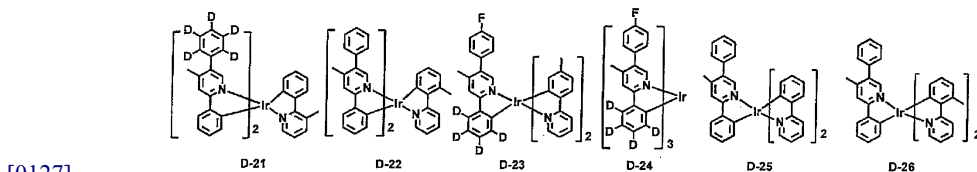
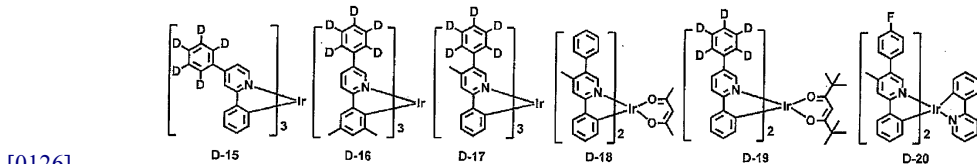
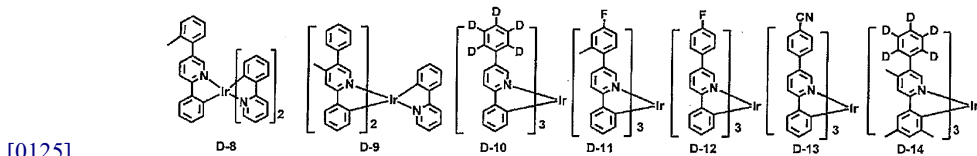
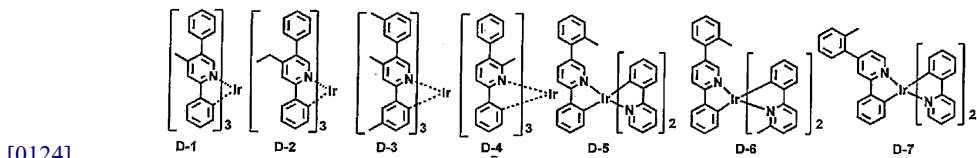
[0119] R_{124} 내지 R_{127} 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 치환 또는 비치환(C1-C30)알킬, 또는 치환 또는 비치환 (C1-C30)아릴이고; R_{124} 내지 R_{127} 가 아릴기인 경우 인접기가 서로 연결되어 융합고리를 형성할 수 있는데, 예를 들어 플루오렌 형성이 가능하며;

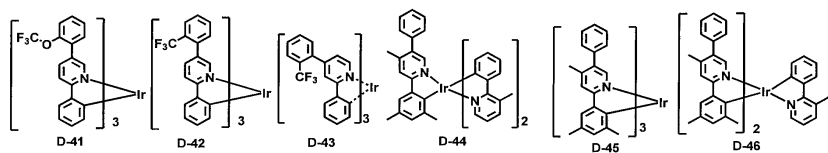
[0120] R_{201} 내지 R_{211} 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 또는 할로젠으로 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 또는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬이고;

[0121] f 및 g 는 각각 독립적으로 1 내지 3의 정수이며; f 또는 g 가 각각 2이상의 정수인 경우 각각의 R_{100} 은 서로 동일 하거나 상이할 수 있고;

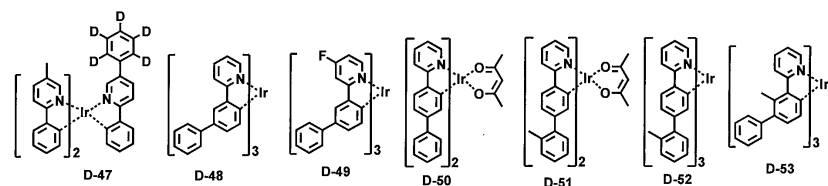
[0122] n 은 1 내지 3의 정수이다.

[0123] 상기 인광 도펀트 재료의 구체적인 예로는 다음과 같다.

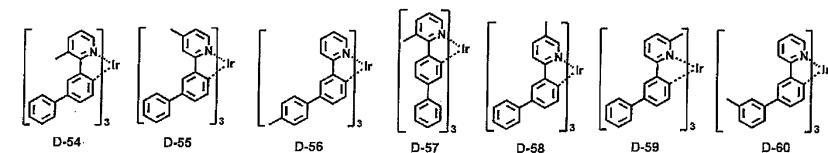




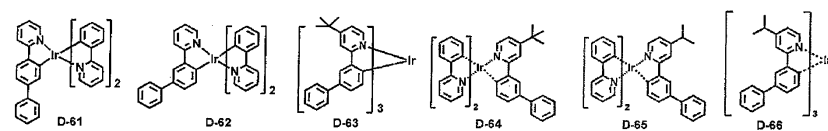
[0130]



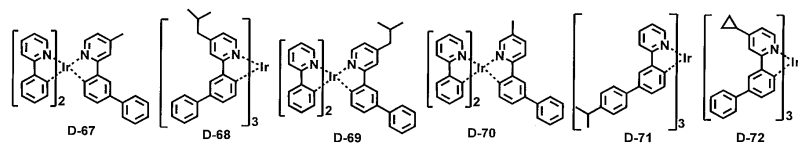
[0131]



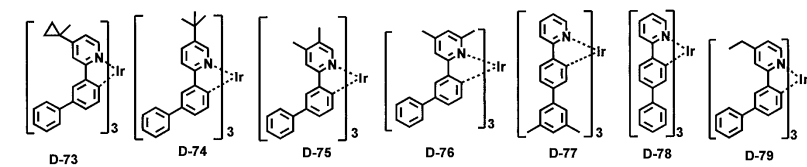
[0132]



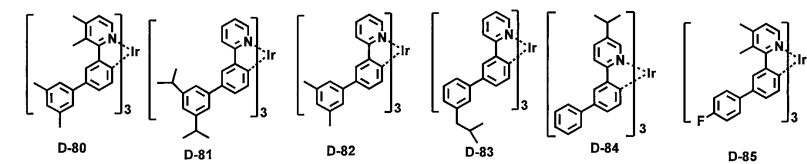
[0133]



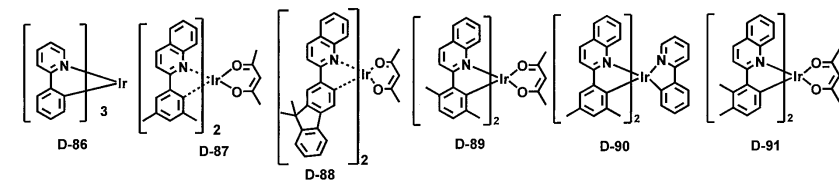
[0134]



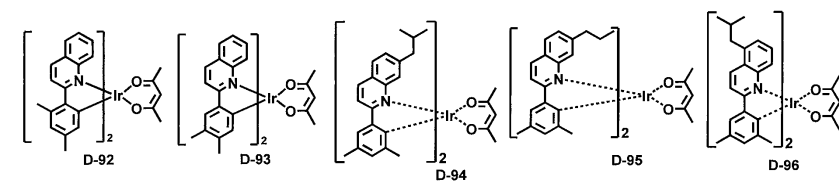
[0135]



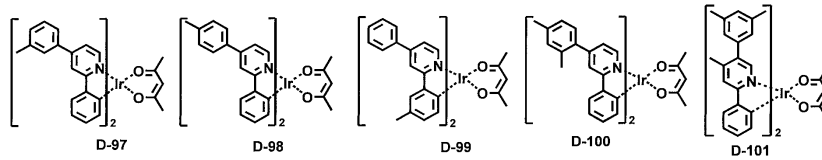
[0136]



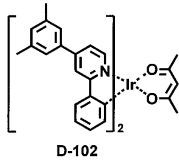
[0137]



[0138]



[0139]



[0140]

[0141]

본 발명은 추가의 양태로 유기 전계 발광 소자 제조용 재료를 제공한다. 상기 재료는 호스트 재료 또는 정공전달층 재료로서 본 발명의 화합물을 포함한다.

[0142]

또한, 본 발명의 유기 전계 발광 소자는 제1전극; 제2전극; 및 상기 제1전극과 제2전극 사이에 개재되는 1층 이상의 유기물층을 가지며, 상기 유기물층은 발광층을 포함하며, 상기 발광층은 본 발명의 유기 전계 발광 소자용 재료를 포함할 수 있다.

[0143]

본 발명의 유기 전계 발광 소자는 화학식 1의 유기 전계 발광 화합물을 포함하고, 이와 동시에 아릴아민계 화합물 또는 스티릴아릴아민계 화합물로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 화합물을 포함할 수 있다.

[0144]

또한, 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 유기물층에 상기 화학식 1의 화합물 이외에 1족, 2족, 4주기, 5주기 전이금속, 란타넘계열금속 및 d-전이원소의 유기금속으로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 금속 또는 착체화합물을 더 포함할 수도 있고, 나아가 상기 유기물층은 추가로 포함되는 하나 이상의 발광층 및 전하생성층을 더 포함할 수 있다.

[0145]

또한, 본 발명의 상기 유기 전계 발광 소자는 본 발명의 화합물 이외에 당업계에 알려진 청색, 적색 또는 녹색 발광 화합물을 포함하는 발광층 하나 이상을 더 포함함으로써 백색 발광을 할 수 있다. 또한, 필요에 따라, 황색 또는 오렌지색 발광층을 더 포함할 수도 있다.

[0146]

본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 한 쌍의 전극의 적어도 한쪽의 내측표면에, 칼코제나이드(chalcogenide)층, 할로젠화 금속층 및 금속 산화물층으로부터 선택되는 일층(이하, 이들을 "표면층"이라고 지칭함) 이상을 배치하는 것이 바람직하다. 구체적으로는, 발광 매체층 측의 양극 표면에 규소 및 알루미늄의 금속의 칼코제나이드(산화물을 포함한다)층을, 또한 발광매체층 측의 음극 표면에 할로젠화 금속층 또는 금속 산화물층을 배치하는 것이 바람직하다. 이것에 의해 구동의 안정화를 얻을 수 있다. 상기 칼코제나이드의 바람직한 예로는 SiO_x ($1 \leq x \leq 2$), AlO_x ($1 \leq x \leq 1.5$), SiON 또는 SiAlON 등이 있고, 할로젠화 금속의 바람직한 예로는 LiF , MgF_2 , CaF_2 , 불화 희토류 금속 등이 있으며, 금속 산화물의 바람직한 예로는 Cs_2O , Li_2O , MgO , SrO , BaO , CaO 등이 있다.

[0147]

또한, 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 이렇게 제작된 한 쌍의 전극의 적어도 한쪽의 표면에 전자수송 화합물과 환원성 도펀트의 혼합 영역 또는 정공수송 화합물과 산화성 도펀트의 혼합 영역을 배치하는 것도 바람직하다. 이러한 방식에 의해 전자수송 화합물이 음이온으로 환원되므로 혼합 영역으로부터 발광 매체에 전자를 주입 및 수송하기 용이해진다. 또한, 정공수송 화합물은 산화되어 양이온으로 되므로 혼합 영역으로부터 발광 매체에 정공을 주입 및 수송하기 용이해진다. 바람직한 산화성 도펀트로서는 각종 루이스산 및 억셉터(acceptor) 화합물을 들 수 있고, 바람직한 환원성 도펀트로는 알칼리 금속, 알칼리 금속 화합물, 알칼리 토류 금속, 희토류 금속 및 이들의 혼합물을 들 수 있다. 또한 환원성 도펀트층을 전하생성층으로 사용하여 두 개 이상의 발광층을 가진 백색 유기 전계 발광소자를 제작할 수 있다.

[0148]

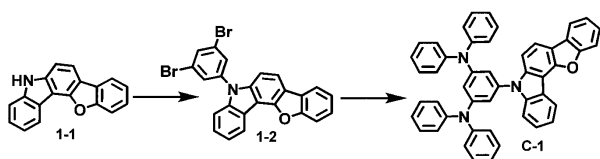
본 발명의 유기 전계 발광 소자의 각층의 형성은 진공증착, 스핀코팅, 플라즈마, 이온플레이팅 등의 건식 성막법이나 스핀 코팅, 침지 코팅(dip coating), 플로우 코팅 등의 습식 성막법 중의 어느 하나의 방법을 적용할 수 있다.

[0149]

습식 성막법의 경우, 각 층을 형성하는 재료를 에탄올, 클로로포름, 테트라하이드로퓨란, 디옥산 등의 적절한 용매에 용해 또는 분산시켜 박막을 형성하는데, 그 용매는 각 층을 형성하는 재료가 용해 또는 분산될 수 있고, 성막성에 문제가 없는 것이라면 어느 것이어도 된다.

[0150] 이하에서, 본 발명의 상세한 이해를 위하여 본 발명의 대표 화합물을 들어 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물, 이의 제조방법 및 소자의 발광 특성을 설명한다.

[0151] [실시예 1] 화합물 C-1의 제조



[0152]

[0153] 화합물 1-2의 제조

[0154] 화합물 1-1 (13.7 g, 53.3 mmol), 1,3,5-트리브로모벤젠 (42.0 g, 133.4 mmol), CuI (1.0 g, 5.33 mmol), 1,10-페난트롤린 (0.9 g, 5.33 mmol), 및 K_2CO_3 (8.0 g, 58.7 mmol)를 디메틸포름아미드(DMF) 270 mL에 녹인 후 190℃에서 7시간 동안 교반하였다. 반응 후 H_2O 를 천천히 넣어 반응을 종결시킨 후 에틸 아세테이트로 유기층을 추출하였다. 추출한 유기층을 마그네슘 설페이트를 이용하여 건조시킨 후, 실리카겔 컬럼 크로마토그래피법으로 분리하여 화합물 1-2 (12.0 g, 47 %) 을 얻었다.

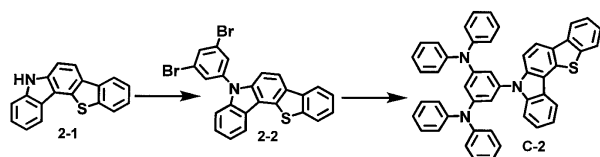
[0155]

화합물 C-1의 제조

[0156] 화합물 1-2 (8.0 g, 16.0 mmol), 디페닐아민 (6.5 g, 38.6 mmol), $Pd_2(dba)_3$ (0.58 g, 0.643 mmol), $P(o-Tol)_3$ (0.78 g, 2.57 mmol), 및 NaOt-Bu (4.6 g, 48.2 mmol)을 톨루엔 (100 mL)에 녹인 후 120℃에서 2시간 동안 교반하였다. 반응 후 H_2O 를 천천히 넣어 반응을 종결시킨 후 에틸 아세테이트로 유기층을 추출하였다. 추출한 유기층을 마그네슘 설페이트를 이용하여 건조시킨 후, 실리카겔 컬럼 크로마토그래피법으로 분리하여 화합물 C-1 (8.3 g, 77 %) 을 얻었다.

[0157] 물성데이터 : 녹는점 285℃, UV 366nm(톨루엔 내), PL 480nm(톨루엔 내), MS/ EIMS 측정값 667.53

[0158] [실시예 2] 화합물 C-2의 제조



[0159]

[0160] 화합물 2-2의 제조

[0161] 화합물 2-1 (8 g, 0.029 mol), 1,3,5-트리브로모벤젠 (27.7 g, 0.087 mol), CuI (552 mg, 0.0029 mol), 1,10-페난트롤린 (528 mg, 0.0029 mol), K_2CO_3 (4.4 g, 0.03 mol), 및 디메틸포름아미드(DMF) 200 mL을 사용하여 화합물 1-1의 합성법과 동일한 방법으로 제조하여 화합물 2-2 (6.5 g, 44 %) 을 얻었다.

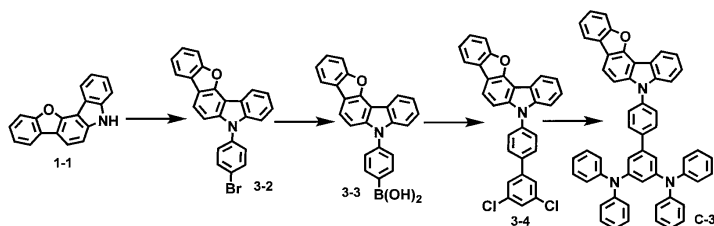
[0162]

화합물 C-2의 제조

[0163] 화합물 2-2 (6 g, 0.0118 mol), 및 디페닐아민 (6 g, 0.0354 mol) 를 넣고 $Pd(OAc)_2$ (80 mg, 0.35 mmol), $P(t-Bu)_3$ (0.5 mL, 0.0011 mol), NaOt-Bu (3.4 g, 0.0354 mol), 및 톨루엔 (120 mL)을 넣어 녹인 후 120℃에서 10 시간 동안 교반하였다. 반응 후 H_2O 를 천천히 넣어 반응을 종결시킨 후 에틸 아세테이트로 유기층을 추출하였다. 추출한 유기층을 마그네슘 설페이트를 이용하여 건조시킨 후, 실리카겔 컬럼 크로마토그래피법으로 분리하여 화합물 C-2 (3.5 g, 43 %) 을 얻었다.

[0164] 물성데이터 : 녹는점 240℃, UV 307 nm(톨루엔 내), PL 380 nm(톨루엔 내), MS/ EIMS 측정값 683.7

[0165] [실시예 3] 화합물 C-3의 제조



[0166]

[0167] 화합물 3-2의 제조

[0168] 화합물 1-1(30 g, 0.12 mol), 1-브로모-4-아이오도벤젠 (73 g, 0.26 mol), CuI (11 g, 0.05 mol), 인산칼륨 (74 g, 0.35 mol), 및 톨루엔 (600 ml)을 넣은 후 120℃에서 3시간 동안 교반하였다. 반응 종결 후 여과하고 메탄올로 씻어준 후 컬럼 크로마토그래피하였다. 감압 하에서 용매를 제거한 후, 재결정하여 화합물 3-2(39 g, 82 %)을 얻었다.

[0169] 화합물 3-3의 제조

[0170] 화합물 3-2(25 g, 0.06 mol) 및 테트라하이드로퓨란 (300 mL)을 넣은 후 질소하에서 교반하면서 -78℃ 에서 노르말-부틸리튬 (36 mL, 2.25 M) 을 천천히 넣어주었다. -78℃ 에서 1시간 교반하고, -78℃ 에서 트리스아이소프로필보란 (28 mL, 0.12 mol) 을 천천히 넣은 후 상온으로 온도를 올려 12시간 반응하였다. 반응 종결 후 에틸아세테이트를 사용하여 추출한 뒤 유기층을 무수 마그네슘 설페이트로 건조하고, 거른 후 감압 하에서 용매를 제거한 후, 재결정하여 화합물 3-3 (20 g, 89 %)를 얻었다.

[0171] 화합물 3-4의 제조

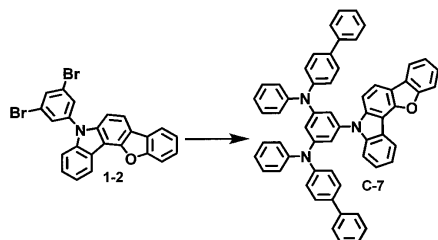
[0172] 화합물 3-3(10 g, 0.02 mol), 1-브로모-3,5-다이클로로벤젠 (7.2 g, 0.03 mol), 테트라키스(트라이페닐포스핀)팔라듐(0) (0.92 mg, 0.79 mmol), 탄산나트륨 (5.6 g, 0.05 mol), 톨루엔(130 ml), 에탄올 (33 ml), 및 증류수 (33 ml)을 넣은 후 120℃에서 12시간 교반하였다. 반응 종결 후 에틸아세테이트를 사용하여 추출한 뒤 유기층을 무수 마그네슘 설페이트로 건조하고, 거른 후 감압 하에서 용매를 제거한 후, 컬럼크로마토그래피로 분리하여 화합물 3-4 (4.4 g, 35 %)을 얻었다.

[0173] 화합물 C-3의 제조

[0174] 화합물 3-4 (4.4 g, 0.009 mol), 디페닐아민 (3.4 g, 0.02 mol), Pd(OAc)₂ (0.4 g, 0.02 mol), 에스-포스 (1.5 g, 3.7 mol), 및 자일렌 (100 ml)을 넣은 후 120℃에서 3시간 교반하였다. 반응 종결 후 여과하고 메탄올로 씻어준 후 컬럼 크로마토그래피하였다. 감압 하에서 용매를 제거한 후, 재결정하여 화합물 C-3(2 g, 30 %)을 얻었다.

[0175] 물성데이터 : 녹는점 222℃, UV 376nm(톨루엔 내), PL 413nm(톨루엔 내), MS/ EIMS 측정값 743.89

[0176] [실시예 4] 화합물 C-7의 제조

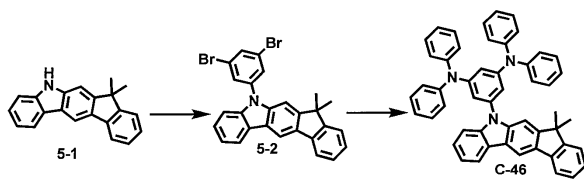


[0177]

[0178] 화합물 1-2 (4.2 g, 8.55 mmol), N-페닐바이페닐-4-아민 (4.8 g, 19.6 mmol), Pd₂(dba)₃ (0.31 g, 0.34 mmol), P(o-Tol)₃ (0.41 g, 1.36 mmol), NaOt-Bu (2.4 g, 25.6 mmol), 및 톨루엔 50 mL을 사용하여 화합물 C-1의 합성 법과 동일한 방법으로 제조하여 화합물 C-7 (5.5 g, 78 %)을 얻었다.

[0179] 물성데이터 : 녹는점 289℃, UV 368nm(톨루엔 내), PL 382nm(톨루엔 내), MS/ EIMS 측정값 820.01

[0180] [실시예 5] 화합물 C-46의 제조



[0181]

[0182] 화합물 5-2의 제조

[0183] 화합물 5-1 (7.3 g, 25.76 mmol), 1,3,5-트리브로모벤젠 (24.3 g, 77.28 mmol), CuI (0.5 g, 2.58 mmol), 1,10-페난트린 (0.5 g, 2.58 mmol), K_2CO_3 (3.9 g, 28.34 mmol), 및 DMF 130 mL을 사용하여 화합물 1-1의 합성법과 동일한 방법으로 제조하여 화합물 5-2 (4.1 g, 31 %)을 얻었다.

[0184] 화합물 C-46의 제조

[0185] 화합물 5-2 (4.1 g, 7.93 mmol), 디페닐아민 (3.2 g, 19.02 mmol), $Pd_2(dba)_3$ (0.3 g, 0.32 mmol), $P(o-Tol)_3$ (0.4 g, 1.27 mmol), NaOt-Bu (2.3 g, 23.79 mmol), 및 톨루엔 80 mL을 사용하여 화합물 C-1의 합성법과 동일한 방법으로 제조하여 화합물 C-46 (3 g, 55 %)을 얻었다.

[0186] 물성데이터 : mp 247°C, UV 370 nm(톨루엔 내), PL 389 nm(톨루엔 내), MS/ EIMS 측정값 693.5

[0187] [소자 제조예1] 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물을 이용한 OLED 소자 제조

[0188] 본 발명의 발광 재료를 이용한 구조의 OLED 소자를 제작하였다. 우선, OLED용 글래스(삼성-코닝사 제조)로부터 얻어진 투명전극 ITO 박막(15Ω/□)을, 트리클로로에틸렌, 아세톤, 에탄올, 증류수를 순차적으로 사용하여 초음파 세척을 실시한 후, 이소프로판올에 넣어 보관한 후 사용하였다. 다음으로 진공 증착 장비의 기관 홀더에 ITO 기관을 장착한 후, 진공 증착장비 내의 셀에 $N^1, N^{1'}-([1,1'-\text{비페닐}]-4,4'-\text{디일})\text{비스}(N^1-(\text{나프탈렌-1-일})-N^4, N^4\text{-디페닐벤젠-1,4-디아민})$ 을 넣고 챔버 내의 진공도가 10^{-6} torr에 도달할 때까지 배기시킨 후, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 ITO 기관 위에 60 nm 두께의 정공주입층을 증착하였다. 이어서, 진공 증착 장비 내의 다른 셀에 C-46을 넣고, 셀에 전류를 인가하여 증발시켜 정공주입층 위에 20 nm 두께의 정공전달층을 증착하였다. 정공주입층, 정공전달층을 형성시킨 후, 그 위에 발광층을 다음과 같이 증착시켰다. 진공 증착 장비 내의 한쪽 셀에 호스트로서 9-(3-(4-(6-디페닐-1,3,5-트리아진-2-일)페닐)-9'-페닐-9H,9'H-3,3'-비스카바졸을 넣고, 또 다른 셀에는 도펀트로서 D-1을 각각 넣은 후, 두 물질을 다른 속도로 증발시켜 도펀트와 호스트 전체에 대하여 도펀트를 15 중량%로 도핑함으로써 상기 정공전달층위에 30 nm 두께의 발광층을 증착하였다. 이어서 상기 발광층 위에 전자전달층으로서 한쪽 셀에 2-(4-(9,10-디(나프탈렌-2-일)안트라센-2-일)페닐)-1-페닐-1H-벤조[d]이미다졸을 넣고, 또 다른 셀에는 리튬 퀴놀레이트(Lithium quinolate)를 각각 넣은 후, 두 물질을 같은 속도로 증발시켜 각각 50 중량%로 도핑함으로써 30 nm의 전자전달층을 증착하였다. 이어서 전자 주입층으로 리튬 퀴놀레이트를 2 nm 두께로 증착한 후, 다른 진공 증착장비를 이용하여 Al 음극을 150 nm의 두께로 증착하여 OLED 소자를 제작하였다. 재료 별로 각 화합물은 10^{-6} torr 하에서 진공 승화 정제하여 사용하였다.

[0189] 그 결과, 3.5 mA/cm^2 의 전류가 흘렀으며, 1850 cd/m^2 의 녹색발광이 확인되었다.

[0190] [소자 제조예 2] 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물을 이용한 OLED 소자 제조

[0191] 정공전달층으로서 C-2을 20 nm 두께로 증착하고 발광층으로서 진공 증착 장비내의 한쪽 셀에 호스트로서 9-페닐-3-(4-(9-(4-페닐퀴나졸린-2-일)-9H-카바졸-3-일)페닐)-9H-카바졸을 넣고, 또 다른 셀에는 도펀트로서 D-87을 각각 넣은 후, 두 물질을 다른 속도로 증발시켜 도펀트와 호스트 전체에 대하여 도펀트를 3 중량%로 도핑함으로써 상기 정공전달층 위에 30 nm 두께의 발광층을 증착한 것 이외에는 소자 제조예 1과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제작하였다.

[0192] 그 결과, 21.8 mA/cm^2 의 전류가 흘렀으며, 2840 cd/m^2 의 적색발광이 확인되었다.

[0193] [소자 제조예 3] 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물을 이용한 OLED 소자 제조

[0194] 정공전달층으로서 C-7을 20 nm 두께로 증착한 것 이외에는 소자 제조예1과 동일한 방법으로 OLED소자를 제작하

였다.

[0195] 그 결과, 5.9 mA/cm^2 의 전류가 흘렀으며, 2880 cd/m^2 의 녹색발광이 확인되었다.

[0196] [소자 제조예 4] 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물을 이용한 OLED 소자 제조

[0197] 정공전달층으로서 C-1을 20 nm 두께로 증착한 것 이외에는 소자 제조예2와 동일한 방법으로 OLED소자를 제작하였다.

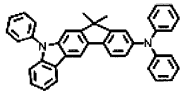
[0198] 그 결과, 28.7 mA/cm^2 의 전류가 흘렀으며, 3500 cd/m^2 의 적색발광이 확인되었다.

[0199] [비교예1] 종래의 유기 전계 발광 화합물을 이용한 OLED 소자의 제조

[0200] 정공전달층으로서 하기 화학식 10의 화합물을 20 nm 두께로 증착한 것 이외에는 소자 제조예 1과 동일한 방법으로 OLED소자를 제작하였다.

[0201] 그 결과, 19.9 mA/cm^2 의 전류가 흘렀으며, 7850 cd/m^2 의 녹색발광이 확인되었다.

[0202] [화학식 10]

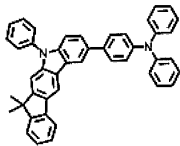


[0203] [비교예2] 종래의 유기 전계 발광 화합물을 이용한 OLED 소자의 제조

[0205] 정공전달층으로서 하기 화학식 11의 화합물을 20 nm 두께로 증착한 것 이외에는 소자 제조예 2와 동일한 방법으로 OLED소자를 제작하였다.

[0206] 그 결과, 14.5 mA/cm^2 의 전류가 흘렀으며, 1480 cd/m^2 의 적색발광이 확인되었다.

[0207] [화학식 11]



[0208]

[0209] 위의 소자 제조예1 및 3과 비교예1의 결과, 및 소자 제조예 2 및 4와 비교예2의 결과를 비교해 볼 때, 본 발명의 유기 전계 발광 화합물을 사용한 소자 제조예 1 내지 4에서 보다 우수한 전류효율을 나타내는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 본 발명에서 개발한 유기 전계 발광 화합물 및 이를 사용하는 유기 전계 발광 소자들이 종래의 것들보다 우수한 발광특성을 갖는다.

[0210] 따라서, 본 발명에 따른 유기 전계 발광 화합물은 전류 효율 및 발광 효율이 우수한 유기 전계 발광 소자를 제조할 수 있는 장점이 있다.

专利名称(译)	标题：有机电致发光化合物和含有它的有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR1020140081421A	公开(公告)日	2014-07-01
申请号	KR1020120151150	申请日	2012-12-21
[标]申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料有限公司		
申请(专利权)人(译)	룸엔드하스전자재료코리아유한회사		
当前申请(专利权)人(译)	룸엔드하스전자재료코리아유한회사		
[标]发明人	AHN HEE CHOON 안희춘 YANG SOO JIN 양수진 MOON DOO HYEON 문두현 JUN JI SONG 전지송 LEE TAE JIN 이태진 LEE KYUNG JOO 이경주 KWON HYUCK JOO 권혁주 KIM BONG OK 김봉옥		
发明人	안희춘 양수진 문두현 전지송 이태진 이경주 권혁주 김봉옥		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/50		
CPC分类号	C09K2211/1011 H01L51/0072 C09K2211/1029 C09K2211/1092 H01L51/0061 C07D495/04 C09K2211/1007 H05B33/14 C09K11/06 H01L51/0071 C07D487/04 C07D491/048 C09K2211/1088 C09K2211/1014 C07D209/80 C07D209/94 H01L51/0067		
代理人(译)	李昌勋		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及新型有机电致发光化合物和包含该化合物的有机电致发光器件。根据本发明的有机电致发光化合物具有可以生产具有改善的电流效率和发光效率的OLED器件的优点。

